

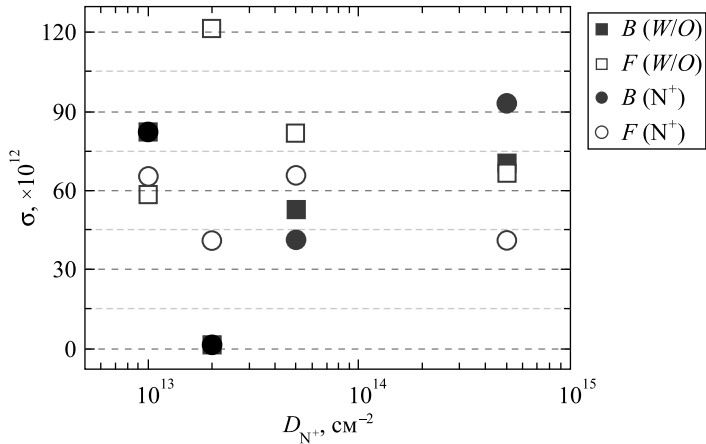


Рис. 2. Зависимость величины дисперсии уровня шума (σ) транзистора ($V_g = -10 \dots +10$ В) от дозы имплантации азота (D_{N^+}) при прямом (F) и обратном (B) порядке термообработки для контрольных (W/O) и имплантированных (N^+) образцов. Доза имплантации $2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$ соответствует энергии имплантации 40 кэВ, для остальных доз энергия имплантации составляет 20 кэВ

Fig. 2. Dependence of the dispersion of the noise level (σ) of the transistor ($V_g = -10 \dots +10$ V) on the dose of nitrogen implantation (D_{N^+}) with the direct (F) and reverse (B) order of heat treatment for control (W/O) and implanted (N^+) samples. Implantation dose of $2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ corresponds to an implantation energy of 40 keV, for other doses the implantation energy is 20 keV